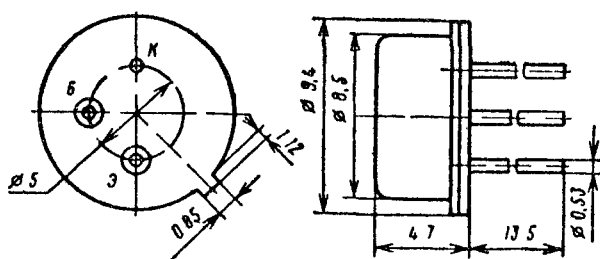


## 2Т836 (А, Б, В)

Транзисторы кремниевые планарные структуры *p-n-p* переключабельные. Предназначены для применения в переключающих устройствах, усилителях мощности, источниках вторичного электропитания. Корпус металлический со стеклянными изоляторами и гибкими выводами.

Масса транзистора не более 2 г.

2Т836 (А-В)



### Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при  $U_{КБ}=5$  В,  $I_B=2$  А:

$T = +25$  °С:

2Т836А . . . . . 20...50\*...100\*

2Т836 (Б, В) . . . . . 20...65\*...100\*

$T_{н} = +125$  °С, не менее . . . . . 20

$T_{к} = -60$  °С, не менее . . . . . 10

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при  $U_{КБ}=5$  В,  $I_{К}=50$  мА . . . . .

4...30\*...40\* МГц

Граничное напряжение при  $I_B=0,1$  А:

2Т836А . . . . . 80...100\*...125\* В

2Т836Б . . . . . 80...90\*...110\* В

2Т836В . . . . . 40...60\*...80\* В

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при  $I_{К}=2$  А.

2Т836А при  $I_B=0,2$  А . . . . . 0,25\*...0,45\*...0,6 В

2Т836Б при  $I_B=0,08$  А . . . . . 0,25\*...0,29\*...0,35 В

2Т836В при  $I_B=0,2$  А . . . . . 0,25\*...0,3\*...0,45 В

Напряжение насыщения база — эмиттер при  $I_{К}=2$  А:

2Т836А при  $I_B=0,2$  А . . . . . 0,95\*...1\*...1,3 В

2Т836Б при  $I_B=0,08$  А . . . . . 0,9\*...1\*...1,2 В

2Т836В при  $I_B=0,2$  А . . . . . 0,95\*...1\*...1,3 В

Время включения при  $U_{КЭ}=85$  В,  $I_{К}=2$  А,  $I_B=0,08$  А . . . . .

0,25\*...0,4\*...0,6 мкс

Время выключения при  $U_{КЭ}=85$  В,  $I_{К}=2$  А,  $I_B=0,08$  А . . . . .

0,31\*...0,9\*...1,6 мкс

Время спада при  $U_{КЭ}=85$  В,  $I_{К}=2$  А,  $I_B=0,08$  А . . . . .

0,1\*...0,4\*...0,6 мкс

Время рассасывания при  $U_{КЭ}=85$  В,  $I_{К}=2$  А,  $I_B=0,08$  А . . . . .

0,2\*...0,6\*...1 мкс

Обратный ток коллектора при  $U_{КБ}=U_{КБ,макс}$ , не более:

$T_{к} = -60 \dots +25$  °С . . . . . 0,1 мА

$T_{к} = +125$  °С . . . . . 3 мА

Обратный ток эмиттера при  $U_{БЭ}=5$  В, не более . . . . . 1 мА

Емкость коллекторного перехода при  $U_{КБ}=5$  В,  $f=1$  МГц . . . . .

340\*...350\*...370 пФ

Емкость эмиттерного перехода при  $U_{БЭ}=0,05$  В,  $f=1$  МГц . . . . .

1500\*...2200\*...2500 пФ

### Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор — база:

2Т836А . . . . . 90 В

2Т836Б . . . . . 85 В

2Т836В . . . . . 60 В

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при  $R_{бэ} \leq 100$  Ом:

2Т836А . . . . . 90 В

2Т836Б . . . . . 85 В

2Т836В . . . . . 60 В

Постоянное напряжение эмиттер — база . . . . . 5 В

Постоянный ток коллектора . . . . . 3 А

Импульсный ток коллектора при  $t_u \leq 10$  мс,  $Q \geq 2$  . . . . . 4 А

Постоянный ток базы . . . . . 1 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при  $T_{к} = -60 \dots +25$  °С:

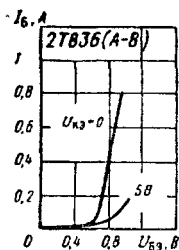
с теплоотводом . . . . . 5 Вт

без теплоотвода . . . . . 0,7 Вт

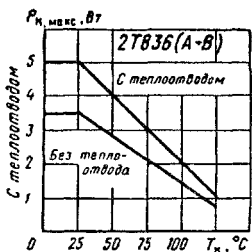
Температура *p-n* перехода . . . . . +150 °С

Температура окружающей среды . . . . . -60 °С... $T_{к} = +125$  °С

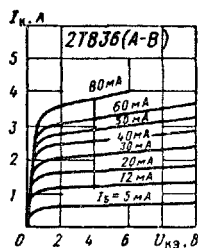
Пайка выводов транзисторов допускается не ближе 3 мм от корпуса при температуре +260 °С в течение не более 3 с.



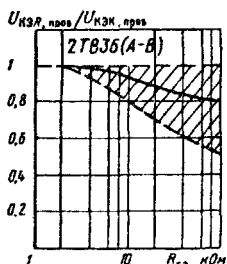
Входные характеристики



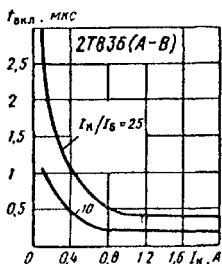
Зависимость максимально допустимой постоянной рассеиваемой мощности коллектора от температуры корпуса



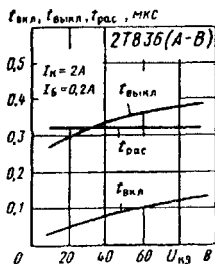
Выходные характеристики



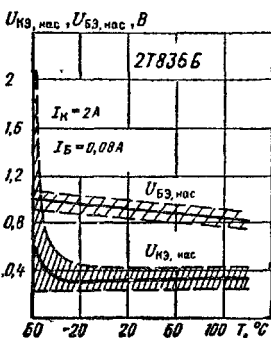
Зона возможных положений зависимости пробивного напряжения коллектор — эмиттер от сопротивления база — эмиттер



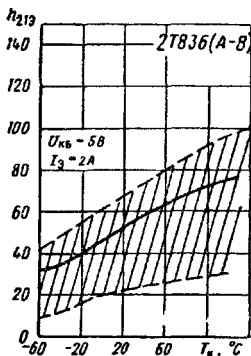
Зависимости времени включения от тока коллектора



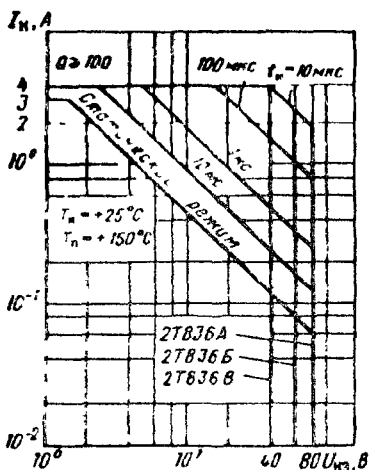
Зависимости времени включения, выключения и рассеивания от напряжения коллектор — эмиттер



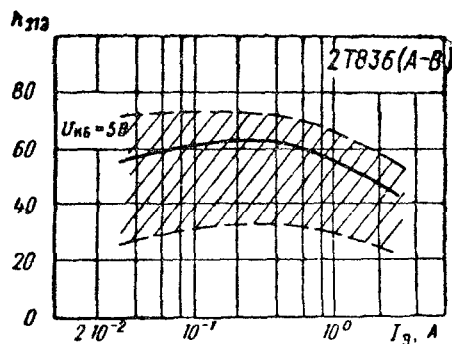
Зоны возможных положений зависимостей напряжений насыщения коллектор — эмиттер и база — эмиттер от температуры



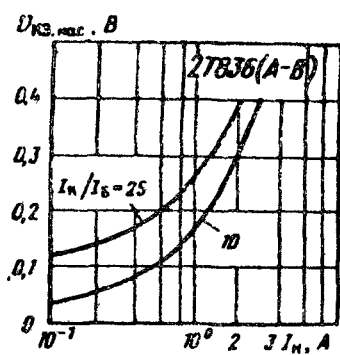
Зона возможных положений зависимости статического коэффициента передачи тока от температуры корпуса



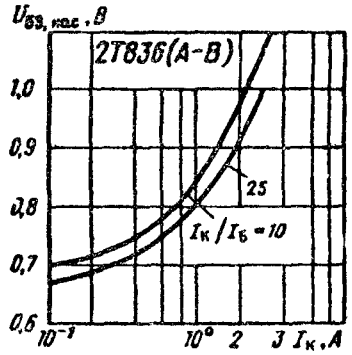
Области максимальных режимов



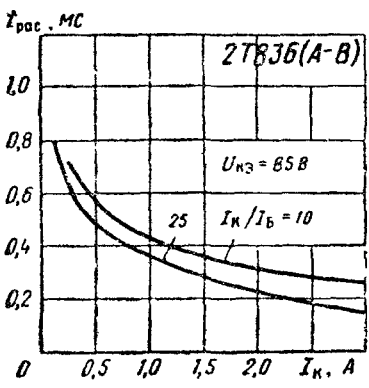
Зона возможных положений зависимости статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера



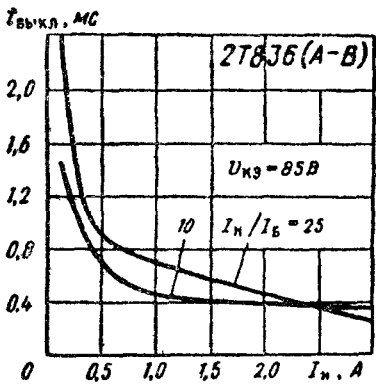
Зависимости напряжения насыщения коллектор — эмиттер от тока коллектора



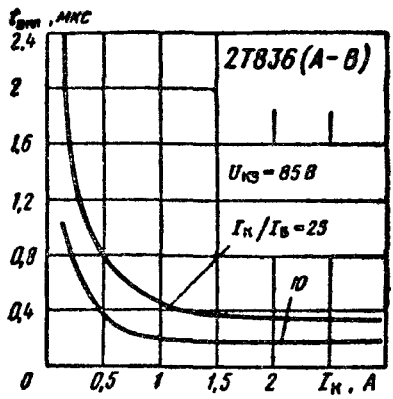
Зависимости напряжения насыщения база — эмиттер от тока коллектора



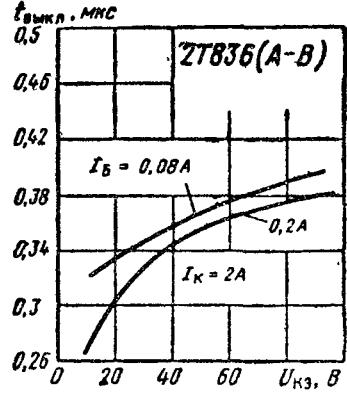
Зависимости времени рассасывания от тока коллектора



Зависимость времени выключения от тока коллектора



Зависимости времени включения от тока коллектора



Зависимости времени выключения от напряжения коллектор — эмиттер